PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-203724

(43) Date of publication of application: 30.07.1999

(51)Int.CI.

G11B 7/24

G11B 7/26

(21)Application number : 10-003485

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

09.01.1998

(72)Inventor: NISHIDA MASATATSU

SAKAMOTO TETSUHIRO KASHIWAGI TOSHIYUKI

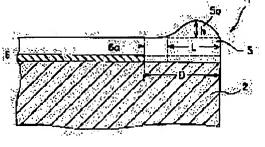
FURUKI MOTOHIRO

(54) OPTICAL DISK AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical disk which has a light transparent layer suppressing the generation of build-up parts in an outer peripheral part as much as possible and having a good surface characteristic and is so formed as to allow a further increase of its capacity and a production method thereof.

SOLUTION: The optical disk 1 is successively formed with a recording part 6 and the light transparent layer 5 on a substrate 2. Light is made incident on the optical disk from the light transparent layer 5 side and the signal recording region 6a of the recording section 6 is subjected to recording and/or reproducing of information signals. The distance D is a diametral direction from the



outermost peripheral part to the signal recording region 6a of the substrate 2 is set larger than the width L in the diametral direction of the built-up part 5a generated in the outer peripheral part of the light transparent layer 5. The height (h) from the surface of the light transparent layer 5 of the built-up part 5a is $\leq 70 \mu m$.

Searching PAJ Page 2 of 2

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] , 22.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平11-203724

(43)公開日 平成11年(1999)7月30日

(51) Int.CL ⁶		織別配号	ΡI		
GIIB	7/24	535	GllB	7/24	535E
	7/26	5 3 1		7/26	531

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 12 頁)

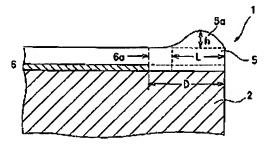
(21)出顧番号	特顧平10-3495	(71)出頃人 000002185
		ソニー株式会社
(22)出版日	平成10年(1998) 1月9日	東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72) 発明者 西田 真達
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(72) 発明者 坂本 哲洋
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(72) 発明者 柿木 俊行
		東京都品川区北品川6丁目7番95号 ソニ
		一株式会社内
		(74)代理人 非理士 小池 晃 (外2名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ディスク及びその製造方法

(57)【要約】

て表面性の良好な光透過層を有し、更なる大容量化が可能とされた光ディスク及びその製造方法を提供する。 【解決手段】 光ディスク1は、基板2上に記録部6、光透過層5が順次形成されており、光透過層5側から光が入射されて記録部6の信号記錄領域6aに対して情報信号の記錄及び/又は再生が行われる。基板2の最外周部から信号記錄領域6aまでの径方向の距離Dは、光透過層5の外周部に生じた隆起部5aの径方向の帽上よりも大きくなされている。そして、この隆起部5aの光透過層5の表面からの高されが70μm以下である。

【課題】 外周部における隆起部の発生が極力抑えられ



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開

特開平11-

(43)公開日 平成11年(

(51) Int.CL.8		織別配号	ΡI		
GllB	7/24	5 3 5	GllB	7/24	535E
	7/26	5 3 1		7/26	531

審査請求 京請求 請求項の数18 OL

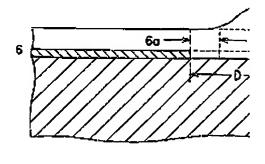
(21)出顯番号	特顯平10-3485	(71)出願人 000002185 ソニー株式会社
(22)出版日	平成10年(1998) 1月9日	東京都品川区北品川6丁目7
	,	(72)発明者 西田 真達 東京都品川区北品川6丁目7
		一株式会社内
		(72)発明者 坂本 哲学 東京都品川区北品川6丁目7
		一株式会社内
		(72)発明者 柏木 俊行 東京都品川区北品川6丁目?
		一株式会社内
		(74)代理人 非理士 小池 晃 (外2名

(54) 【発明の名称】 光ディスク及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 外層部における隆起部の発生が極力抑えられて表面性の良好な光透過層を有し、更なる大容量化が可能とされた光ディスク及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 光ディスク1は、基板2上に記録部6、 光透過層5が順次形成されており、光透過層5側から光 が入射されて記録部6の信号記録領域6aに対して情報 信号の記録及び/又は再生が行われる。基板2の最外周 部から信号記録領域6aまでの経方向の距離Dは、光透 過層5の外間部に生じた降起部5aの後方向の幅1.より



(2)

30

特関平 1 1 -

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に記録層、光透遺層が順次形成されており、当該光透過層側から光が入射されて上記記録 層の信号記録領域に対して情報信号の記録及び/又は再生が行われる光ディスクにおいて、

1

上記墓板の最外周部から上記信号記録領域までの径方向 の距離は、上記光透過層の外周部に生じた隆起部の径方 向の幅よりも大きくなされており、

当該隆起部の上記光透過層の表面からの高さが?()μm 以下であることを特徴とする光ディスク。

【請求項2】 上記隆起部の上記光透過層の表面からの高さが20μm以下であることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。

【請求項3】 上記基板の最外周部から信号記録領域までの径方向の医解をD[mm]とし、上記光透過層の外周部に形成された隆起部の径方向の帽をL[mm]とすると、

D - O. 5 ≥ L [mm] を満足していることを特徴とす。 る請求項1記載の光ディスク。

【請求項4】 上記隆起部の経方向の幅上が1.5 mm 20 大きな回転数で当該基板を回転させる第以下であることを特徴とする請求項1記載の光ディス 上記第2の工程後に、上記第2の工程についませた回転数よりも小さな回転数で上記第2の工程に対象といる。

【請求項5】 上記隆起部の経方向の帽上が1.0mm 以下であることを特徴とする請求項1記載の光ディス ク。

【請求項6】 基板上に記録層、光透過層が順次形成されてなり、当該光透過層側から光が入射されて情報信号の記録及び/又は再生が行われる光ディスクの上記光透過層を形成する際に、

上記記録層が形成された基板上に紫外線硬化樹脂を塗布 する工程と、

上記繁外線硬化樹脂が塗布された基板を回転させるとともに、当該紫外線硬化樹脂に対して繁外線を照射して当該繁外線硬化樹脂を硬化させる工程とを備えることを特徴とする光ディスクの製造方法。

【請求項7】 上記紫外線硬化樹脂を塗布する工程は、 上記記録層が形成された墓板上に紫外線硬化樹脂を滴下 して当該基板を回転しながら当該紫外線硬化樹脂を回転 延伸させるものであり、

上記點外線硬化樹脂を硬化させる工程は、上記點外線硬 40 クの製造方法。

上記光透過板を回転させるとともに、上記 脂に対して紫外線を照射させ、

上記紫外線硬化樹脂を硬化させる工程後 板を剥離することを特徴とする請求項で クの製造方法。

【請求項9】 上記基板は、外周部が切されていることを特徴とする請求項6記の製造方法。

【請求項10】 上記紫外線硬化樹脂を 行った後に且つ上記紫外線硬化樹脂を硬 前に、上記紫外線硬化樹脂を塗布する際 よりも大きな回転数で当該墓板を回転さ ることを特徴とする請求項7記載の光デ 法。

> 【請求項11】 上記紫外線硬化樹脂をiは、上記基板を回転させるとともに、上記 記録領域上に塗布された紫外線硬化樹脂。 昭射させて硬化させる第1の工程と、

上記第1の工程において基板を回転させ、 大きな回転数で当該基板を回転させる第 上記第2の工程後に、上記第2の工程に 転させた回転数よりも小さな回転数で上。 せるともに、少なくとも上記信号記録師 に塗布された繁外線硬化樹脂に対して繁 て硬化させる第3の工程とを備えること。 求項7記載の光ディスクの製造方法。

【語求項12】 上記基板上の信号記録 る領域以外の領域に対して繁外線を照射 紫外線硬化樹脂を塗布する工程を行うこ を特徴とする語求項7記載の光ディスク 【語求項13】 上記紫外線硬化樹脂を は、形成される光ディスクの外径と略同 る環状の領助基板を用いて、その内部に させて上記基板を支持する第1の工程と 及び基板に対して紫外線硬化樹脂を滴下 板及び基板を回転しながら当該紫外線硬 伸させる第2の工程とを備え、

上記繁外級硬化樹脂を硬化させる工程後 板を剥離することを特徴とする請求項? クの製造方法。

(3)

30

待關平11-

【請求項16】 上記紫外線硬化樹脂を塗布する工程を 行った後に、墓板の最外層部上に塗布された紫外線硬化 樹脂の一部を吸引手段で吸引することを特徴とする請求 項6記載の光ディスクの製造方法。

【請求項17】 上記紫外線硬化樹脂を塗布する工程を 行った後に、墓板の最外層部上に塗布された紫外線硬化 樹脂の一部を気体質射手段により吹き飛ばすことを特徴 とする請求項6記載の光ディスクの製造方法。

【請求項18】 上記紫外線硬化樹脂は、粘度が400 Ocps以上であることを特徴とする語求項6記載の光 10 いる。 ディスクの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板上に記録層、 光透過層が順久形成されてなり、当該光透過層側から光 を入射して上記記録層の信号記録領域に対して情報信号 の記録及び/又は再生が行われる光ディスク及びその製 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】オーディオ用、ビデオ用、その他各種情 20 級を記録する光記録媒体としては、例えば、エンボスピ ットによって情報信号が予め書き込まれる光ディスク や 記録膜の組変化を利用して情報信号が書き込まれる 相変化型光ディスクや、記録膜の磁気光学効果を利用し て情報信号が書き込まれる光磁気ディスク等が挙げられ る。 これらの光ディスクは、透明基板上に記録層、光 反射層、保護層が順次形成されてなり、透明基板側から レーザ光が入射されて、上記記録層に対して情報信号の 記録及び/又は再生が行われる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の光デ ィスクでは、光ディスクの記録密度が、用いるレーザ光 額の最小スポット径によって決まる。つまり、このレー ザスポット径が小さい程。高密度記録が可能となる。こ のレーザスポット径は、記録再生光学系の入/NA (A:レーザ光の波長、NA:対物レンズの関口数)に 比例する。よって、光ディスクの高密度記録化を図るた めには、レーザ光の波長人を短くし、対物レンズの関口 数NAを上げることが必要となる。

[()()() 4] しかし、対物レンズの開口数NAを上げる 46 [()()11] しかしながら この第2の

る。このように、従来の光ディスクに対 の波長人の短波長化や対物レンズの高N. により記録密度を向上させる方法は、技術 ているのが現状である。

【0006】そとで、本発明者は、更な・ を可能とする光ディスクとして、基板上に 録層、光透過層が順次形成されてなり。。 レーザ光を入射させて上記記録層の信号 で情報信号の記録及び/又は再生を行う

【①①①7】特に、この光ディスクは、 層、記録層、光透過層を順次成膜すると するため、レーザ光が入射される光透過 度良く作製することができる。その結果 クは、対物レンズの高NA化に十分対応 り、記録密度の向上が図られる。

【0008】ととで、この光ディスクの. 形成する方法としては、例えば、基板上 緑層を順次形成した後に、当該記録層上に mの樹脂シートを厚み数μmの透明接着) させて樹脂シートからなる光透過層を形 法と、当該記録層上に紫外線硬化樹脂を 外線硬化樹脂を回転延伸させた後に基板・ 懲で斃外線を照射して当該斃外線硬化樹 ことにより光透過層を形成する第2の方:

【0009】第1の方法では、形成され。 みの均一性は良好であるが、樹脂シート 折等の点から製造が困難であり寒用上実 【0010】一方、第2の方法は、具体 センタ孔に一時的に蓋をして、このセン 硬化樹脂を適下してこの繁外線硬化樹脂。 た後に、基板を静止させた状態で紫外線! よって当該紫外線硬化樹脂を硬化させて: する方法である。この第2の方法は、コ ク(CD)などの従来の光ディスクの保 技術の延長上にあるため、材料の取扱い。 ウハウ、装置の設計等についても実用上に 置産にも適している。

(4)

5

【①①12】例えば、従来のCDと同様なサイズの基板上に膜厚100μmの紫外線硬化樹脂を塗布して回転延伸させた後に基板を静止させた状態で紫外線照射を行って光透過層を形成すると、外周部にディスクの径方向の幅が5mm以上となされた隆起部が形成されてしまい、信号記録領域を結果的に狭めてしまう。

【①①13】とのように、信号記録領域に影響を及ばす 【発明程の帽を有する隆起部が光透過層の外層部に形成されて 態についまうと、信号記録領域の確保が困難となり、結果的 は、対 に、記録容置の向上が不可能なばかりか、却って記録容 10 ある。 置の滅縮にもつながりかねない。具体的には、高記録容 【①(置を実現するには、CDやDVD等と同等の信号記録領 上に、域を確保することが必要であり、そのためには、この光 成され 透過層の外周部に形成される隆起部の帽は、最低限1. 号記録 5 m m 以下になされていなければならない。 は、デ

【①①14】そこで、本発明は、従来の実情に鑑みて提案されたものであり、外層部における隆起部の発生が極力抑えられて表面性の良好な光透過層を有し、更なる大容量化が可能とされた光ディスク及びその製造方法を提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する ために完成された本発明に係る光ディスクは、基板上に 記録層、光透過層が順次形成されており、当該光透過層 側から光が入射されて上記記録層の信号記録領域に対し て情報信号の記録及び/又は再生が行われるものであ

り、上記基板の最外周部から上記信号記録領域までの経 方向の距離が、上記光透過層の外周部に生じた隆起部の 経方向の幅よりも大きくなされており、当該隆起部の上 記光透過層の表面からの高さが70μm以下であること を特徴とするものである。

【①①16】以上のように構成された本発明に係る光ディスクは、製造後に光透過層の外周部に生じる隆起部の幅や高さが上述したように制限されているため、表面上の凹凸が極力抑えられた光透過層を有する表面性に優れたものとなり、そのため、信号記録領域を極力広くとることができる。

【①①17】また、上述した目的を達成するために完成 04~0.35重量%、2nを0.25 された本発明に係る光ディスクの製造方法は、基板上に 1を0.15重量%以下の割合で含有す。 記録層、光透過層が順次形成されてなり、当該光透過層 40 れる。また、このときの光反頻層3は 1

ィスクの製造方法は、紫外線照射を行う! 化樹脂が塗布された基板を回転しながら! 樹脂に対して紫外線を照射するため、基! 位置する紫外線硬化樹脂が表面張力によ 戻り隆起部を生じるといった現象が極力! 【0020】

【発明の実施の形態】以下、本発明の具に 態について、図面を参照しながら詳細には、本発明を適用した光ディスクの一例。 ある。

【①①21】本発明を適用した光ディス上に、光反射層3、記録層4、光透過層成されてなる。ここで、光反射層3及び号記録部6を構成する。そして、この光は、光透過層5側から光を入射させて信して情報信号の記録及び/又は再生が行【①②22】墓板2は、一主面2a上に号が記録される案内操やプリグループ等形成されている。この基板2の厚みは、

20 mmが好ましい。また、この基板2の様 えば、ポリカーボネートやポリメチルメ (PMMA)等のアクリル系樹脂よりな。 基板やガラス量板等が挙げられる。前者 成形によって、後者の場合にはフォトポ 法)によって、基板2が成形される。

【①①23】この基板2の一主面2aに 上に形成される光反射層3は、記録層4・ 反射する反射層として機能するとともに に熱が離もるのを防止するヒートシンク 30 する。

> 【0024】この光反射層3の材料とし、 素、半金属元素、半導体元素及びそれらい あるいは複合させて用いるのが望ましい。 【0025】中でも、好ましくは、A1-Siを0.4~0.8重量%、Feを0. 下、Cuを0.15~0.40重量%、i 重量%以下、Mgを0.8~1.2重量! 04~0.35重量%、Znを0.25; 1を0.15重量%以下の割合で含有す。

> > 4/21/2005

30

8

DCスパッタ法、RFスパッタ法といった手法が挙げる れるが、中でもイオンビームスパッタ法が好適である。 【① 0 2 8 】記録層 4 は、レーザ光の照射によって情報 信号の書き込み・消去が可能な光記録層である。との記 録層には、結晶と非結晶との間で可逆的に相変化する相 変化材料層や、キュリー温度を超えた温度上昇によって 保磁力がなくなり外磁界の方向に磁化反転する光磁気記 録層等が設けられている。

【①①29】組変化材料層には、単体のカルコゲンやカ ルコゲン化合物が用いられる。具体的には、Te、Se の各単体、Ge-Sb-Te, Ge-Te, in-Sb -Te, in-Se-Te-Ag, In-Se. In-Se-Ti-Co, in-Sb-Se, BilTel, B !Se, Sb, Se, Sb, Te, 等のカルコゲナイト系 材料が使用される。

【0030】また、光磁気記録層には、Tb-Fe-C ○等の非晶質合金薄膜等の、カー効果やファラデー効果 等の磁気光学特性を有する垂直磁化膜等が用いられる。 【0031】なお、再生専用の光ディスクの場合には、 信号パターンに応じた所定の凹凸パターンが基板2に形 20 成されており、この凹凸パターン上に光反射層3が緻暖 されて記録部が構成されている。

【0032】光透過層5は、情報信号の記録再生時にレ ーザ光が入射される。また、この光透過層5は、湿気等 の腐食因子と接触するのを防止する保護層としても機能 する。

【0033】光透過層5は、記録部6上に紫外線硬化樹 脂を後述する本発明を適用した製造方法によって成膜す るととにより形成される。

【0034】との光透過層5は、厚さが3μm~177 μηνであることが好ましい。これは、光透過層5の厚み の下限が、記録層4や光反射層3を保護する役割を有す る光透過層の保護機能が確保されるかによって決定され るためである。すなわち、光ディスクの信頼性や、対物 レンズの光透過層5表面への衝突の影響を考慮すると、 3μm以上であることが必要である。一方、将来、レー ザ光等の短波長化が進んで、現状の赤色レーザから将来 普及が見込まれる青色レーザまで対応することを考慮す ると、光透過層5の最大厚みは、177μmであること が好ました。

【①038】特に、本発明を適用した光・ は、図2に示すように、製造工程後に光 部に生じる隆起部5 a の光透過層6表面: 70 µm以下である。

【0039】ところで、光ディスクの高 るためには、本発明を適用した光ディス が照射される光透過層5が薄膜化された ピックアップにおける対物レンズの高N. る。このように、光透過層5側から光を、 10 信号の記録再生を行う光ディスクにおい 度記録化を実現するためには、対物レン. なされた光学ビックアップを用いるので. 学ピックアップと光ディスクとの作動圏 istance) が狭くなる。

> 【①①40】具体的には、上述の光学ビ ディスクとの作動距離は、例えば、光学 設計にもよるが、約100μmである。 は、コンパクトディスク(CD)やDV rsatile Disc)における作動距離よりも である。そのため、このような光ディス DやDVDよりも光学ピックアップに対 い。また、この衝突時における傷を低減 鴬の光学ピックアップには、光ディスク 部にプロテクターが取り付けられており. ターにより、光学ピックアップからプロー 距離は約30μmである。

【①041】よって、光ディスクの読み」 ディスクの作製上絶むを得ない突起がで の高さを70μm以下に抑える必要があ 【()()42】したがって、本発明を適用 1は、光透過層5の外周部に生じる隆起 が70μm以下となされているため。高 求に伴って光学ピックアップにおける対(A化が推進されて光ディスク1と光学ビ 距離である作動距離が狭くなっても、光 と光ディスクとが衝突してしまう現象を ることができる。よって、本発明を適用 1 は、高密度記録化に十分対応可能とな。 【()()43】さらに、光透過層5の隆起 46 は 光ディスクトの表面上に膨等の異物:

(6)

特闘平 1 1 − 10

る。

【0045】とこで、以下、基板2の最外周部から信号 記録領域6aまでの距離をD[mm]とし、光ディスク 1の最外周部に生じる隆起部5aの帽をL[mm]とす る。

9

【0046】ところで、従来のCDでは、光ディスクの直径が約60mmであり、信号記録領域の直径が約5 8.5mmである。つまり、従来のCDでは、ディスクの最外周部から信号記録領域6aまでの距離Dが約1.5mmとなされている。

【① ① 4.7 】そのため、本発明を適用した光ディスク1 においても、従来のCDと同様な記録容置を確保するためには、光透過層5の最外層部に生じる隆起部5 a の幅 Lを、1.5 m m以下とする必要がある。

【① ① 4 8】特に、本発明を適用した光ディスク1では、従来のCD等よりも更なる大容量化を実現するためには信号記録領域6 a をより広くとる必要があるため、例えば、ディスクの最外層部から信号記録領域6 a までの距離Dが約1. ① mmとなされていることが必要である。

【 0 0 4 9 】よって、光ディスク1では、光透過層5の 最外層部に生じる隆起部5 a の幅上が 1. 0 mm以下で あると、更なる大容置化が実現可能となる。

【①①50】また、本発明を適用した光ディスク1では、D-0.5≧L[mm]の関係を満足するものであることが好ましい。つまり、ディスクの最外周部から信号記録領域6aまでの距離Dと、光透過層5の最外周部に生じる隆起部5aの幅しとの差が①.5mm以上であることが好ましい。これにより、隆起部5aが記録又は再生信号に影響を極力与えずに済み、記録再生特性が非 30 意に優れた光ディスク1となるためである。

【① 051】以上述べたように、本発明を適用した光ディスク1は、外層部における隆起部5aの発生が極力抑えられて表面性の良好な光透過層5が形成されたものとなる。その結果、本発明を適用した光ディスク1によれば、より広い信号記録領域を確保することができて見なる大容置化が図られる。また、この光ディスク1は、表面性に優れ且つ機厚の薄い光透過層5が形成されてなり、この光透過層5側から光を入射させて記録部6に対して情報信号の記録再生を行うので、対物レンズの高N 46

1を0.4~0.8宣置%。Feを0. Cuを0.15~0.40重置%、Mn· %以下、Mgを0.8~1.2宣置%。 ~0.35重量%、2nを0.25重量 0.15重置%以下の割合で含有する特 オンビームスパッタ法により膜厚150 3を成膜する。このように、イオンビー、よる成膜方法の方が、例えば、DCスパ 膜する方法よりも、結果的に信号の性質: 10.スクを提供することができる。

【0.055】次に、このように成膜され、に、 $ZnSeSiO_2$ との混合物よりなる保護機、 $GeSbTeよりなる相変化材をSiO_2$ との混合物よりなる第2の誘電体次積層して、記録層4を形成する。

【0056】このとき、例えば、第1の 膜厚を20nmとし、相変化材料膜の膜 し、第2の誘電体保護膜の膜厚を100 【0057】最終的に、記録層4上に斃 20 を、以下に示すスピンコート法により成 0、1mmの光透過層5を形成し、光デれる。

> 【① ① 5 8】とこで、本発明を適用した; 造方法により光透過層 5 を形成する際にi 3 に示すスピンコート装置を用いる。な: 成膜体は、記録層 4 が形成された基板 2 中では、記録層 4 を省略している。

【10059】本発明を適用した光ディスよれば、先ず、中心部に設けられた回転より回転自在に支持されたターンテーブ、緑層4が形成された基板2が配される。膜面である記録層4表面がターンテーブ。る面とは反対側になるように基板2を夕り上に配する。そして、この基板2の中部村12で閉塞させた後、当該基板2を1転数800mpmで回転させながら、基ある蓋部村12上に図中B方向に示すよめ間を適下させて、紫外線硬化樹脂を基上に回転延伸させて塗布する。

【0060】次に、特に本祭明を適用し;

数にすることが望ましく。紫外線硬化樹脂を回転延伸さ せる際の回転数が1000mgm以上の場合、その回転 数の30~60%位の回転数にすることが望ましい。

【10062】なお、従来のスピンコート法では、墓板2 を静止させた状態で紫外線を照射するが、本発明を適用 した光ディスクの製造方法では、上述したように、基板 2を回転させながら紫外線を照射するものである。

【0063】以上示したように、本発明を適用した光デ ィスクの製造方法は、光透過層をスピンコート法により 製造する際に 基板2を回転させながらこの基板2の記 10 録層4上に紫外線硬化樹脂を適下して回転延伸させた 後、墓板2の回転数を減速させるが、この基板2を回転 させながら紫外線硬化樹脂に対して紫外線を照射させ る。

【①064】すなわち、本発明を適用した光ディスクの 製造方法は、上述したように、基板2を回転させなが ら、紫外線照射を行って紫外線硬化樹脂を硬化させる方 法である。具体的には、墓板2を始め800mpmで回 転しながら記録層4上に繁外線硬化樹脂を回転延伸させ た後に、この基板2の回転数を400mmmに減速させ、20 すように、紫外線13を照射させて繁煌 てとのまま回転させながら斃外線照射する。

【0065】ととで、以下に、本発明を適用した光ディ スクの製造方法を用いて光ディスクを製造した実験例を 赤す。

【10066】先ず、直径120mmの墓板を射出成形に より成形して用意した。そして、この墓板上に鮎度22 (1) cpsの繁外線硬化樹脂を適下して回転数81()r pmで回転延伸させ、厚さが100μmの紫外線硬化樹 脂を塗布した。

【0067】そして、この墓板を400mpmの回転数 30 で回転させながら、25秒間紫外線照射を行って当該紫 外線硬化樹脂を硬化させて光透過層を形成し、最終的に 光ディスクを得た。

【0068】とのように作製した光ディスクは、光透過 層の外周部に生じた隆起部の幅上が約3mmとなった。

【0069】また、同様な墓板上に鮎度4500cps の紫外線硬化樹脂を滴下して、回転数1200 rpmで 回転延伸させて、厚さが100μmの紫外線硬化樹脂を 塗布した。そして、この基板を500 rpmの回転数で 回転させながら 2.5 秒間整外線昭射を行って当該整外 40

製造方法によれば、表面性の良好な光透。 且つ信号記録領域6 a を極力広く効果的 きて更なる大容量化を実現可能とされた。 製造することができる。

【0073】なお、以下に示すように、! う前に適下した繁外線硬化樹脂上にガラ. ても良い。

【①①74】すなわち、図5に示すよう。 ンテーブル10上に配された基板2上に 14を適下する。このとき、基板2は篩、 ある。

【0075】次に、図6に示すように、 勧貼14上にガラス板15を載置する。 ガラス板15とともに基板2を回転させ、 複硬化樹脂 14が基板 2上の記録層4の:

【りり76】そして、このように、墓板 の全面に紫外線硬化樹脂 1.4 が延伸され 板2をガラス板15とともに回転させな; を観化させて光透過層5を形成する。とい 紫外線硬化樹脂 1.4 が緩り切られて基板 外線硬化樹脂の隆起部が形成されるのを ができる。

【()()77】最後に、ガラス板15を光 離して光ディスク」が製造される。

【りり78】とのように、ガラス板15. 脂上に戴置することによって、表面が平に 5の表面性がそのまま表面に転写された。 成されることになるため、より表面性に 5を製造するととができる。この製造方: 板15といった使用部材が1つ増えるが、 15自体はその他の光ディスクの光透過 にも同様にして用いることができ、すな るため、コストアップという点において ない。また、この製造方法では、ガラスに る工程が1つ増えるが、この工程は非常に ため、製造効率を著しく悪化させるよう: į,

【①079】なお、本発明を適用した光。

14

(8)

13

隆起部の発生を効果的に且つ容易に抑えられた光透過層 を形成することができる。また、この方法は、基板2の 成形時に基板2上の案内溝や情報信号に対応する凹凸ビ ット等を形成する方法と同様に切り欠き部2aを形成す ることができるので、製造上の手間がかからない。ま た。この切り欠き部2aは、通常の基数2を成形後にエ ッチング等により形成しても良く、この方法によっても 形成が簡単である。

【①081】なお、本発明を適用した光ディスクの製造 方法としては、繁外線硬化樹脂を滴下する前に、予め基 10 -板2の最外周部に紫外線を照射させても良い。 すなわ ち、図9に示すように、先ず、紫外線硬化樹脂を滴下す る前に、基板2の最外周部となる部分を除く部分をマス ク16で覆い、その最外層部に対して、例えば、液長が 200~300nmの短波長紫外線、いわゆるDEEE P UVを照射する。このように、最外周部に短波長紫 外線を照射すると、最外層部の塗れ性が良好になる。な お、とこで、この最外周部とは、詳しくは、信号記録領 域よりも外側の領域であり、基板2及び/又は記録部6 の最外国部である。

【①①82】次に、このマスク板16を剥離し、その 後、図3及び図4と同様にして紫外線硬化樹脂の塗布工 程及び回転硬化工程を行って、最終的に光透過層りを形 成する。

【①083】との方法によれば、予め隆起部が生じ易い 基板2の最外層部に短波長紫外線を照射させて最外層部 の塗れ性を良好な状態としておくため、光透過層5の最 外層部における隆起部の発生が効果的に且つ容易に極力 抑えられて、表面性の良好な光透過層5が形成される。 なお この短波長紫外線により影響を受ける部分の選択 30 性は、当製造方法において高精度が求められるものでは ないので問題はなく、マスク板16による制御のみで十 分確保される。

【()()84】なお、本発明を適用した光ディスクの製造 方法としては、図3に示すように紫外線硬化樹脂を基板 2上に適下して回転延伸させた後、紫外線照射する前 に、紫外線硬化樹脂により接覆された基板2をより高速 で短時間回転させても良い。すなわち、紫外線硬化樹脂 を墓板2上に滴下して回転延伸させた後に、回転支持部 材11の同転数を上げて との基板2を短時間回転させ 46 回転させながら 紫外線硬化樹脂21を

線硬化樹脂に対して行った後に、基板をi から、信号記録領域以外の領域上の繁化 して紫外線照射を行っても良い。

【①087】すなわち、図3に示すよう 樹脂を基板2上に回転延伸させた後に、: 領域6aよりも外側の紫外線硬化樹脂上。 外線硬化樹脂上にマスク17,18を施 示すように、この基板2を回転させなが 行う。このとき、信号記録領域6 a 以外 マスク17で覆われているため、信号記述 る繁外線硬化樹脂のみに繁外線が照射さ: 硬化樹脂が硬化される。

【0088】そして、このマスク17を に示すように、その後、この基板2を高: る。とれにより、外国部の余分な紫外線 切られる。

【()()89】その後、回転支持部材110 させて基板2の回転を続け、図4に示し、 硬化樹脂の回転硬化工程を行って光透過 20 る。

【()()9()】とのように、先ず信号記録(外線硬化樹脂に紫外線照射を行った後に. て外層部の余分な紫外線硬化樹脂を振り 部の繁外線硬化樹脂に対して紫外線照射・ って、より表面性に優れた光透過層らを 易に形成するととができる。この方法は、 工程が1つ増加するが、繁外線硬化樹脂・ 後にマスクをせずに高速回転することに、 分な紫外線硬化樹脂を緩り切る前述の方: 選択的に外層部の余分な繁外線硬化樹脂・ ができる。

【①①91】なお、本発明を適用した光 方法としては、図12に示すように、鍵 スクの外径と略同一な内径を有し、且つ: 同一な厚みを有するリング20を用いる。 る。この方法では、先ず、このリング2 板2を嵌合させる。

【1) 0.9.2】そして、図1.3に示すよう ング20とともに回転支持部材11によ

16

<u>1</u>5

に嵌合させてこれらリング20及び基板2上に繁外線硬化樹脂を塗布した後に硬化させ、その後にリング20及びリング20上の紫外線硬化樹脂を取り外すことにより、表面に隆起部等の凹凸が極力抑えられた表面性の良好な光ディスクを製造することができる。この方法は、隆起部が生じやすい外周部の紫外線硬化樹脂を光透過層として用いないため、非常に表面性が良好な光ディスクとなる。

【①①96】なお、本発明を適用した光ディスクの製造方法としては、通常の基板の外径よりも若干大きめの外 16 径を有する基板を用いる方法でも良い。すなわち、通常の基板の外径よりも若干大きめの径を有する基板22を用いて、その基板22上に記録部を形成した後に、図3及び図4に示したように、基板22を回転させながら紫外線硬化樹脂を硬化させて、図16に示すような通常の基板の外径よりも若干大きめな径を有する光透過層23を形成する。最終的に、図16中矢印Cに示すように、通常の基板と同じサイズとなるように、光透過層23及び基板22の余分な外周部25を切断して、光ディスク1を製造する。 20

【① 0 9 7】とのように、予め径の大きめな光透過層を 形成しておき、回転硬化後に余分な外層部の光透過層を 切断する方法によれば、隆起が生じやすい外層部の紫外 線硬化樹脂を光透過層として用いないために、非常に表 面性が良好となる。

【①①98】なお、本発明を適用した光ディスクの製造方法としては、繁外線硬化樹脂を基板2上の記録層の全面に回転延伸させた後に当該紫外線硬化樹脂を硬化する前に、最外周部の余分な繁外線硬化樹脂を布のような樹脂を吸収する物質で拭き取ってから、図4に示したような繁外線硬化樹脂の回転硬化工程を行っても良い。

【①①99】また、本発明を適用した光ディスクの製造 方法としては、繁外線硬化樹脂を基板2上の記録層の全 面に回転延伸させた後に当該紫外線硬化樹脂を硬化する 前に、最外周部の余分な紫外線硬化樹脂を真空ボンプ等 で吸引してから、図4に示したように基板2を回転させ て紫外線照射を行っても良い。

【① 1 ① ① 】また、本発明を適用した光ディスクの製造 方法としては、繁外線硬化樹脂を基板2上の記録層の全 面に回転延伸させた後に当該紫外線硬化樹脂を硬化する 40

を用いるとより効果が奏される。 【 0 1 0 3 】

【発明の効果】以上詳細に説明したよう。 る光ディスクは、製造後に光透過層の外 起部の幅や高さが上述したように制限さい 表面上に凹凸が極力抑えられた光透過層 に優れたものとなり、結果的に信号記録 とることができて見なる大容置化を図る る。

10 【0104】また、以上詳細に説明した。 に係る光ディスクの製造方法は、紫外線 に、紫外線硬化樹脂が塗布された基板を 試繁外線硬化樹脂に対して紫外線を照射 の外層部上に位置する紫外線硬化樹脂が て内層部側に戻ってきて隆起部が生じる 極方防がれる。その結果、本発明に係力抑 層を有する豪面性に優れた光ディスクを 可能となる。また、その結果、この光デ 法によれば、信号記録領域を極力広くを 更なる大容置化を図ることができる光デ ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を適用した光ディスクの図である。

【図2】本発明を適用した光ディスクに: 拡大して示す断面図である。

【図3】本発明を適用した光ディスクの』 で、繁外線硬化樹脂を塗布する工程を示 30 る。

> 【図4】本発明を適用した光ディスクの』 で、繋外線硬化樹脂に対して紫外線を照 す断面図である。

> 【図5】 本発明を適用した光ディスクの て、 紫外線硬化樹脂を塗布する工程を示する。

> 【図6】図5に示す紫外線硬化樹脂の塗の紫外線硬化樹脂上にガラス板を戴置さ、 断面図である。

49 【図?】ガラス仮を戯聞したことによっ。

BEST AVAILABLE COPY

(10)

特闘平11-

18

対して紫外線を照射する工程を示す断面図である。

【図11】図10に示す工程の後に、マスクを剥離して 基板を高速で回転させる工程を示す断面図である。

【図12】本発明を適用した光ディスクの製造方法において、基板の外層部にリングを取り付ける工程を示す断面図である。

【図13】図12に示す工程後に、リング及び記録層が 形成された基板に対して繁外線硬化樹脂を塗布する工程 を示す断面図である。

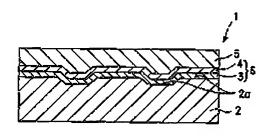
【図14】図13に示す工程後に、繁外線硬化樹脂に対 10 して繁外線照射を行う工程を示す断面図である。 *

*【図15】図14に示す工程後に、リンの繁外線硬化樹脂を除去する工程を示す 【図16】本発明を適用した光ディスク て、通常の基板よりも大きいサイズの基準 過層を形成する方法を示す断面図である。 【図17】従来の光ディスクの外周部を注面図である。

【符号の説明】

 光ディスク. 2 基板、 3 光/ 記録層、 5 光透過層. 5 a 隆起i

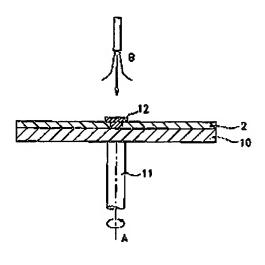
【図1】



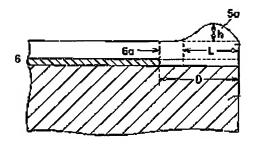
1:光ディスク 2:英説 3:光度観響

4:208個 5:発透過 6:33秒

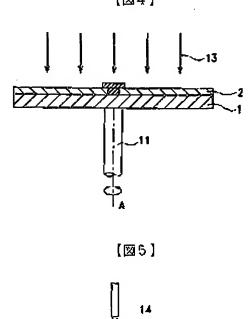
[図3]



【図2】



[図4]

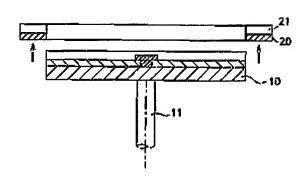


特闘平11-(11)[図8] [**2**7] [210] [図9] [212] [211] [図]4] [213]

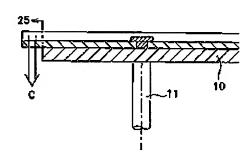
BEST AVAILABLE COPY

特闘平11-

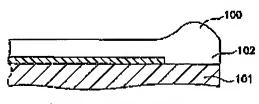
[図15]



【図16】



[217]



資金の光ディスクの外角部を示すが過ぎ

フロントページの続き

(72)発明者 古木 基裕

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内